

Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0100U006399

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-12-2000

Статус виконавця: співвиконавець

Номер РК головного виконавця: 0100U004220



II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 5 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науково-виробниче підприємство "Електрон-Карат"-дочірнє підприємство ПрАТ "Концерн-Електрон"

Код за ЄДРПОУ: 23273999

Місцезнаходження: вул. Стрийська, 202, м. Львів, Львівська обл., 79031, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2631065

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження профілю розподілу неконтрольованих донорів в шарах HgCdTe, одержаних методом МПЕ

Назва роботи англійською:

Exploration of unmesurable donor impurities sn the HgCdTe layers fabricated by the MBE method

Мета роботи українською:

Метою роботи є дослідження властивостей структур CdHgTe, отриманих методом МПЕ, для створення багатoeлементних фотодіодів діапазону 8-12 мкм на їх основі

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Буде досліджено рівень неконтрольованого донорного легування МПЕ шарів CdHgTe та створено експериментальні зразки лінійок фотодіодів з наступними параметрами: Діапазон чутливості, мкм- 8-12; Розмір чутливої площадки, мкм - 50x50; Чутливість, В/Вт - 10000; Крок між елементами, мкм - 50;

Галузь застосування:

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Іжнін І.І.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Відпрацювання методики визначення рівня донорного легування в МПЕ шарах

Початок етапу: 07.2000

Закінчення етапу: 12.2000

Вид звітнього документа: Без звіту

Номер етапу: 2

Назва етапу: Визначення рівня донорного легування в МПЕ структурах, отриманих в різних технологічних циклах

Початок етапу: 01.2001

Закінчення етапу: 12.2001

Вид звітнього документа: Без звіту

Номер етапу: 3

Назва етапу: Дослідження дії іонно-променевого травлення на МПЕ структури та відпрацювання технології створення р-п переходів

Початок етапу: 01.2002

Закінчення етапу: 12.2002

Вид звітнього документа: Без звіту

Номер етапу: 4

Назва етапу: Виготовлення дослідних зразків лінійок фотодіодів та дослідження параметрів

Початок етапу: 01.2003

Закінчення етапу: 12.2003

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 681.2:347.77; 681.2:001.894/.895, 621.315.592

Коди тематичних рубрик: 59.01.21

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Ваків М.М.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності



Юрченко Т.А.